This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

```
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
014276076
             **Image available**
WPI Acc No: 2002-096778/200213
XRAM Acc No: C02-030025
XRPX Acc No: N02-071467
  Light-emitting material for forming a light-emitting device which is
  useful in, e.g., display device, comprises an orthometalated iridium
  complex compound or its tautomer
Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (FUJF ); IGARASHI T (IGAR-I);
  KIMURA K (KIMU-I); NII K (NIIK-I)
Inventor: IGARASHI T; KIMURA K; NII K
Number of Countries: 002 Number of Patents: 003
Patent Family:
Patent No
              Kind
                     Date
                             Applicat No
                                            Kind
                                                   Date
                                                            Week
<u>US 20010019782</u> A1 20010906 US 2000747933
                                              Α
                                                  20001227
                                                            200213
JP 2001247859 A
                   20010914 JP 2000299495
                                                 20000929
                                             Α
                                                           200213
JP 2001345183 A
                   20011214
                             JP 2000298470
                                             Α
                                                 20000929
                                                           200214
Priority Applications (No Type Date): JP 2000299495 A 20000929; JP 99370349
  A 19991227; JP 200089274 A 20000328; JP 2000298470 A 20000929
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                         Main IPC
                                     Filing Notes
                     37 H05B-033/12
US 20010019782 A1
JP 2001247859 A
                    28 C09K-011/06
JP 2001345183 A
                    16 H05B-033/14
Abstract (Basic): US 20010019782 A1
      NOVELTY - A light-emitting material comprises an orthometalated
    iridium complex compound or its tautomer.
        DETAILED DESCRIPTION - A light-emitting material comprises an
    orthometalated iridium complex compound having a partial structure of
    formulas (I) to (X), (XXI), and (XXII), or its tautomer.
        (CO) Ir (V);
        (NC) Ir (VI);
        q1, q2=0-4;
        Z11, Z12, Z21, Z22=nonmetallic atom group forming 5-6 membered ring
    with a carbon and/or nitrogen;
       Ln1=divalent group;
       Y1, Y2=N or C;
       b1, b2=single or double bond;
       X201, X202, X203, X204=N or C-R to form a N-containing heteroaryl
    6-membered ring with -C=N-;
       Z201, Z301, Z401=atomic group which forms an aryl or heteroaryl
       Z1=atomic group which forms a heteroaryl ring;
       The sum of q1 and q2 is at least1, and X201, X202, X203, and/or
   X204 is a nitrogen.
       INDEPENDENT CLAIMS are also included for:
        (A) a compound of formulas (XXIII) or (XXIV); and
        (B) an organic light-emitting device comprising compound layers
   containing the light-emitting layer formed interposed between a pair of
   electrodes.
       R13, R14, R15=H;
       m1=0-4;
       m2=0-6;
       Z2=atomic group which forms aryl or heteroaryl ring;
       Z3=atomic group which forms a nitrogen-containing heteroaryl ring;
       n1=1-3.
       USE - The material is used for forming a light-emitting device
   which is useful in display device, display, backlight,
   electrophotography, illuminating light source, recording light source,
   exposure light source, reading light source, sign, or advertising
   display and interior. It is also useful for medical use or as
   fluorescent brightening agent, photographic material,
```

ultraviolet-absorbing material, laser dye, color filter dye, or color conversion filter.

ADVANTAGE - The material is capable of converting electric energy to light, and produces light-emitting device having good light-emitting properties.

pp; 37 DwgNo 0/0

Technology Focus:

TECHNOLOGY FOCUS - IMAGING AND COMMUNICATION - Preferred Material: The light-emitting material is formed by a coating process. The device has an external quantum efficiency of at least 5%, and lambdamax of light emitting of at least 590 nm.

ORGANIC CHEMISTRY - Preferred Component: The quinoline derivative ligand is formed by at least 4 rings.

Title Terms: LIGHT; EMIT; MATERIAL; FORMING; LIGHT; EMIT; DEVICE; USEFUL; DISPLAY; DEVICE; COMPRISE; IRIDIUM; COMPLEX; COMPOUND; TAUTOMER

Derwent Class: E12; G08; L03; U11; X26

International Patent Class (Main): C09K-011/06; H05B-033/12; H05B-033/14

International Patent Class (Additional): C07D-213/02; C07D-213/16;

C07D-213/20; C07D-213/22; C07D-213/26; C07D-213/28; C07D-213/68;

C07D-213/84; C07D-215/04; C07D-217/02; C07D-221/02; C07D-221/10;

C07D-231/12; C07D-237/12; C07D-241/12; C07D-241/16; C07D-247/00;

C07D-263/56; C07D-401/04; C07D-409/04; C07D-471/04; C07F-015/00

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): E05-N; G04-A; G06-F06; G06-F07; G06-G18; L03-C04A; L03-D01D

Manual Codes (EPI/S-X): U11-A15; X26-J

Chemical Fragment Codes (M3):

- *01* A677 A910 F012 F013 F019 F211 F431 M1 M116 M280 M320 M411 M510 M522 M530 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 RA56XU-K RA56XU-U
- *02* A677 A910 D021 E160 M280 M320 M411 M511 M520 M530 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 RA56XV-K RA56XV-U 03524
- *03* A677 A910 D012 D621 G011 G100 M1 M113 M280 M320 M411 M511 M520 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 RA56XW-K RA56XW-U 03524
- *04* A677 A910 F012 F013 F014 F015 F016 F431 G011 G014 G015 G017 G018 G100 M1 M113 M280 M320 M411 M510 M521 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21301-K 0047-21301-U 03524
- *05* A677 A910 F010 F012 F013 F014 F015 F016 F020 F431 F530 F541 F551 F580 F590 G001 G002 G011 G012 G013 G020 G021 G022 G029 G040 G100 G221 M1 M113 M115 M116 M280 M320 M411 M510 M521 M522 M530 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21302-K 0047-21302-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *06* A677 A910 D010 D020 D040 F010 F020 G001 G002 G011 G012 G013 G020 G021 G022 G029 G040 G100 G221 M1 M113 M115 M116 M280 M320 M411 M511 M520 M521 M530 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21303-K 0047-21303-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *07* A677 A910 D012 D621 F010 F020 G001 G002 G011 G012 G013 G020 G021 G022 G029 G040 G100 G221 M1 M113 M115 M116 M280 M320 M411 M511 M520 M521 M530 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21304-K 0047-21304-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *08* A677 A910 D010 D019 D020 D029 D040 D049 F010 F019 F020 F029 M1 M126 M132 M280 M320 M411 M510 M511 M512 M520 M521 M522 M530 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21305-K 0047-21305-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *09* A677 A923 A960 D012 D013 D014 D019 D021 D022 D023 D024 D025 D029 D621 D699 G011 G014 G015 G017 G018 G019 G100 M113 M119 M121 M144 M280 M320 M411 M510 M512 M520 M530 M532 M540 M620 M630 M650 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21306-K 0047-21306-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *10* A677 A923 D012 D013 D014 D019 D021 D022 D023 D024 D025 D029 D621 D699 F010 F019 F020 F029 G011 G014 G015 G017 G018 G019 G100 M1 M113 M116 M119 M121 M123 M126 M129 M144 M280 M320 M411 M511 M512 M513 M520 M522 M523 M531 M532 M533 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21307-K 0047-21307-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247

Ring Index Numbers: ; 03524; 00160; 00177; 00178; 00210; 00211; 00212; 41247

Specific Compound Numbers: RA56XU-K; RA56XU-U; RA56XV-K; RA56XV-U; RA56XW-K

; RA56XW-U

Generic Compound Numbers: 0047-21301-K; 0047-21301-U; 0047-21302-K; 0047-21302-U; 0047-21303-K; 0047-21303-U; 0047-21304-K; 0047-21304-U; 0047-21305-K; 0047-21305-U; 0047-21306-K; 0047-21306-U; 0047-21307-K; 0047-21307-U

Key Word Indexing Terms:

01 450844-0-0-0-CL, USE 450845-0-0-0-CL, USE 450846-0-0-0-CL, USE 0047-21301-CL, USE 0047-21302-CL, USE 0047-21303-CL, USE 0047-21304-CL, USE 0047-21305-CL, USE 0047-21307-CL, USE

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2001-247859 (P2001-247859A)

(43)公開日 平成13年9月14日(2001.9.14)

(51) Int.CL'	識別配号	PΙ		テーマコート゚(参考)
CO9K 11/06	660	C 0 9 K 11/06	660	3K007
C 0 7 D 213/18		C 0 7 D 213/16		4 C 0 3 4
213/20		213/20	•	4 C 0 5 5
213/22		213/22		4C056
213/26	•	213/26		4 C O 6 3
•		審査請求 未請求 請求項の数14	OL (全28頁)	最終質に続く

(21)出觀書号	特觀2000-299495(P2000-299495)	(71)出職人	000005201
(22)出版日	平成12年9月29日(2000.9.29)		宮士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中裕210番地
		(72)発明者	五十嵐 達也
(31)優先権主張番号	特額平11-370349	1	神奈川県南足柄市中福210番地 富士写真
(32) 優先日	平成11年12月27日(1999.12.27)		フイルム株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	木村 桂三
			神奈川県南足柄市中招210番地 富士写真
	•		フイルム株式会社内
		(74)代理人	100105647
			弁理士 小栗 昌平 (外4名)

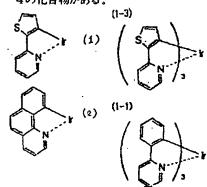
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 オルトメタル化イリジウム蜡体からなる発光来子材料、発光素子および新規イリジウム蜡体

(57)【要約】 (修正有)

【課題】発光特性の優れた発光素子およびそのための材料を提供する。

【解決手段】式 $1\sim2$ 、又は一般式3の部分構造を有するオルトメタル化イリジウム錯体又はその互変異性からなる発光素子材料。具体例にはそれぞれ1-3、1-1、1-4の化合物がある。



 $(R^1 \, \&\, R^2 \, \&\, \&\, \&\, Q^1 \, \&\, Q^2 \, \&\, O \sim 4$ の整数を表し、 $Q^1 + Q^2 \, \&\, 1$ 以上である。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式(1)で表される部分構造を有する 化合物またはその互変異性体からなる発光素子材料。

(化1)

一般式 (1)



【請求項2】一般式(2)で表される部分構造を有する 10 化合物またはその互変異性体からなる発光素子材料。

【化2】

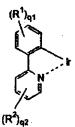
一般式 (2)



【請求項3】一般式(3)で表される部分構造を有する 化合物またはその互変異性体からなる発光素子材料。

【化3】

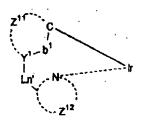
一般式 (3)



式中、 R^1 , R^2 はそれぞれ置換基を表す。 q^1 , q^2 は0 ~ 4 の整数を表し、かつ、 q^1+q^2 は1以上である。 【請求項4】一般式(4)で表わされる部分構造を有する化合物またはその互変異性体。

【化4】

-- 設式(4)



式中、Z¹¹およびZ¹²はそれぞれ炭素原子および/または窒素原子とともに5 員環または6 員環を形成するのに必要な非金属原子団を表わし、この環は置換基を有していても良く、また更に別の環と縮合環を形成してもよい。L n¹は2個の基を表わす。Y¹は窒素原子または炭素原子を表わし、b¹は単結合または二重結合を表わす。

【請求項5】請求項4に記載の化合物からなる発光材料。

【請求項6】一般式(5)で表わされる部分構造を有す 50

2

る化合物からなる発光材料。

【化5】

一般式(5)

(CO)F

【請求項7】一般式(6)で表わされる部分構造を有する化合物からなる発光材料。

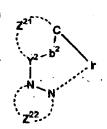
【化6】

一般式(6)

(NC)ir

【請求項8】一般式(7)で表わされる部分構造を有する化合物またはその互変異性体からなる発光材料。 【化7】

一般式(7)



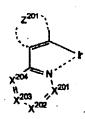
20 式中、Z²¹およびZ²²はそれぞれ炭素原子および/また は窒素原子とともに5員環または6員環を形成するのに 必要な非金属原子団を表わし、この環は置換基を有して いてもよく、また更に別の環と縮合環を形成してもよ い。Y²は窒素原子または炭素原子を表わし、b²は単結 合または二重結合を表わす。

【請求項9】一般式(8)で表される部分構造を有する 化合物またはその互変異性体からなる発光材料。

【化8】

30

一般式(8)



式中、X²⁰¹、X²⁰²、X²⁰³およびX²⁰⁹は、窒素原子またはC-Rを表し、-C=N-とともに含窒素へテロアリール6員項を形成し、X²⁰¹、X²⁰²、X²⁰³およびX²⁰⁴の少なくとも1つは窒素原子を表す。Rは水素原子または置換基を表す。Z²⁰¹はアリール環またはヘテロアリール環を形成する原子団を表す。

【請求項10】一般式(9)で表される部分構造を有する化合物またはその互変異性体からなる発光材料。 【化9】 一般式(9)

式中、Z201、Z301はアリール環またはヘテロアリール 環を形成する原子団を表す。

【請求項11】一般式(10)で表される部分構造を有 10 する化合物またはその互変異性体からなる発光材料。 【化10】

般式(10)

式中、乙201、乙401はアリール環またはヘテロアリール 環を形成する原子団を表す。

【請求項12】一対の電極間に発光層もしくは発光層を 含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子におい て、少なくとも一層に請求項1、2、3、5ないし11 に記載の発光材料を含有する有機発光素子。

【請求項13】一対の電極間に発光層もしくは発光層を 含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子におい て、請求項1、2、3、5ないし11に記載の発光材料 単独からなる層を少なくとも一層有することを特徴とす る有機発光案子。

【請求項14】一対の電極間に発光層もしくは発光層を 30 含む複数の有機化合物薄層を形成した発光器子におい て、少なくとも一層にオルトメタル化イリジウム錯体を 有し、かつ、オルトメタル化イリジウム錯体を含む層を 塗布プロセスで成膜することを特徴とする発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 光に変換して発光できる発光素子用材料および発光素子 に関し、表示素子、ディスプレイ、バックライト、電子 写真、照明光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、 標識、看板、インテリア等の分野に好適に使用できる発 光素子に関する。また、各種分野での応用が期待される 新規発光材料に関する。

[0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発 が活発であり、中でも有機電界発光 (EL) 素子は、低 電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な表 示素子として注目されている。例えば、有機化合物の蒸 着により有機薄膜を形成する発光素子が知られている

3頁、1987年)。この文献に記載された発光素子は トリス (8-ヒドロキシキノリナト) アルミニウム錯体 (A1g)を電子輸送材料として用い、正孔輸送材料 (アミン化合物)と積層させることにより、従来の単層 型素子に比べて発光特性を大幅に向上させている。 【0003】近年、有機EL素子をカラーディスプレイ

へと適用することが活発に検討されているが、高性能力 ラーディスプレイを開発する為には 青・緑・赤、それ ぞれの発光素子の特性を向上する必要が有る。

【0004】発光素子特性向上の手段として、オルソメ タル化イリジウム錯体 (Ir(ppy)3:Tris-Orth o-Metalated Complex of Iri dium(III) with 2-Phenylpyr idine)からの発光を利用した緑色発光素子が報告 されている (Applied Physics Letters 75, 4 (19 99).)。本素子は外部量子収率8%を達しており、 従来素子の限界といわれていた外部量子収率5%を凌駕 しているが、緑色発光に限定されているため、ディスプ レイとしての適用範囲が狭く、高効率で他色に発光する 20 発光素子材料の開発が求められていた。

【0005】一方、有機発光素子において高輝度発光を 実現しているものは有機物質を真空蒸着によって積層し ている素子であるが、製造工程の簡略化、加工性、人面 積化等の観点から塗布方式による素子作製が望ましい。 しかしながら、従来の塗布方式で作製した素子では特に 発光効率の点で蒸着方式で作製した素子に劣っており、 新規発光素子材料の開発が望まれていた。また、近年、 フィルター用染料、色変換フィルター、写真感光材料染 料、増感色素、パルプ染色用染料、レーザー色素、医療 診断用蛍光薬剤、有機発光素子用材料等に蛍光を有する 物質が種々用いられ、その需要が高まっており、新たな 発光材料が望まれていた。

[.0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、発光 特性が良好な発光案子およびそれを可能にする発光案子 用材料の提供および、各種分野で利用可能な新規発光材 料の提供にある。

[0007]

【課題を解決するための手段】この課題は下記手段によ って達成された。

1. 一般式(1)で表される部分構造を有する化合物ま たはその互変異性体からなる発光素子材料。

[0008]

【化11】

-般式 (1)



(アプライド フィジックス レターズ, 51巻, 91 50 【0009】2. 一般式 (2) で表される部分構造を有

以上である。

[0015] 【化14】

*【0013】式中、R1, R2はそれぞれ置換基を表す。

q1, q2は0~4の整数を表し、かつ、q1+q2 は1

【0014】4. 一般式(4)で表わされる部分構造を

有する化合物またはその互変異性体。

する化合物またはその互変異性体からなる発光素子材

[0010]

【化12】

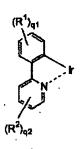
般式 (2)

【0011】3. 一般式(3)で表される部分構造を有 10 する化合物またはその互変異性体からなる発光素子材 料。

[0012]

【化13】

松式 (3)



【0016】式中、Z¹¹およびZ¹²はそれぞれ炭素原子 30%【0022】8、一般式(7)で表わされる部分構造を および/または窒素原子とともに5員環または6員環を 形成するのに必要な非金属原子団を表わし、この環は置 換基を有していても良く、また更に別の環と縮合環を形 成してもよい。Ln1は2個の基を表わす。Y1は窒素原 子または炭素原子を表わし、biは単結合または二重結 合を表わす。

【0017】5. 上記4に記載の化合物からなる発光材

【0018】6. 一般式(5)で表わされる部分構造を 有する化合物からなる発光材料。

[0019]

【化15】

-般式(5)

(CO)r

【0020】7. 一般式(6)で表わされる部分構造を 有する化合物からなる発光材料。

[0021]

【化16】

一般式(6)

有する化合物またはその互変異性体からなる発光材料。 [0023]

【化17】

【0024】式中、Z21およびZ22はそれぞれ炭素原子 および/または窒素原子とともに5員環または6員環を 形成するのに必要な非金属原子団を表わし、この環は置 換基を有していてもよく、また更に別の環と縮合環を形 成してもよい。Y2は窒素原子または炭素原子を表わ し、b²は単結合または二重結合を表わす。

【0025】9. 一般式(8)で表される部分構造を有 する化合物またはその互変異性体からなる発光材料。

[0026]

※50 【化18】

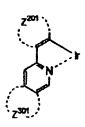
一般式(8)

【0027】式中、X²⁰¹、X²⁰²、X²⁰³およびX ²⁰⁴は、窒素原子またはC-Rを表し、-C=N-とと もに含窒素へテロアリール6 員環を形成し、X201、X ²⁰²、X²⁰³およびX²⁰⁴の少なくとも1つは窒素原子を 表す。Rは水素原子または置換基を表す。Z201はアリ ール環またはヘテロアリール環を形成する原子団を表 す。

10. 一般式(9)で表される部分構造を有する化合物 またはその互変異性体からなる発光材料。

[0028]

【化19】

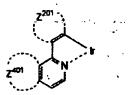


【0029】式中、Z²⁰¹、Z³⁰¹はアリール環またはへ テロアリール環を形成する原子団を表す。

11. 一般式(10)で表される部分構造を有する化合 物またはその互変異性体からなる発光材料。

[0030]

【化20】



【0031】式中、Z201、Z401はアリール環またはへ テロアリール環を形成する原子団を表す。

12. 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数 40 の有機化合物薄層を形成した発光素子において、少なく とも一層に上記1、2、3、5ないし11に記載の発光 材料を含有する有機発光素子。

13. 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数 の有機化合物薄層を形成した発光素子において、1、 2、3、5ないし11に記載の発光材料単独からなる層 を少なくとも一層有することを特徴とする有機発光素 子。

14. 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数

とも一層にオルトメタル化イリジウム錯体を有し、か つ、オルトメタル化イリジウム錯体を含む層を塗布プロ セスで成膜することを特徴とする発光素子。 [0032]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。本発明の化合物はオルトメタル化イリジウム錯体 (orthometalated Ir Complexes) からなる発光素子材 料である。オルトメタル化金属錯体とは、例えば「有機 金属化学-基礎と応用-」p150,232 裳華房社 山本明夫著 1982年発行、「Photochemistry and Ph otophysics of Coordination Compounds p71-p77,p13 5-p146 Springer-Verlag社 H. Yersin著1987年発行 等に記載されている化合物群の総称である。

【0033】オルトメタル化イリジウム錯体のイリジウ ムの価数は特に限定しないが、3値が好ましい。オルト メタル化イリジウム錯体の配位子は、オルトメタル化錯 体を形成し得る物であれば特に問わないが、例えば、ア リール基置換含窒素へテロ環誘導体(アリール基の置機 位置は含窒素へテロ環窒素原子の隣接炭素上であり、ア 20 リール基としては例えばフェニル基、ナフチル基、アン トリル基、フェナントリル基、ピレニル基などが挙げら れ、さらに炭素環、ヘテロ環と縮環を形成しても良い。 含窒素へテロ環としては、例えば、ピリジン、ピリミジ ン、ピラジン、ピリダジン、キノリン、イソキノリン、 キノキサリン、フタラジン、キナゾリン、ナフトリジ ン、シンノリン、ペリミジン、フェナントロリン、ピロ ール、イミダゾール、ピラゾール、オキサゾール、オキ サジアゾール、トリアゾール、チアジアゾール、ベンズ イミダゾール、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾー 30 ル、フェナントリジンなどが挙げられる)、ヘテロアリ ール基置換含窒素へテロ環誘導体(ヘテロアリール基の 置換位置は含窒素へテロ環窒素原子の隣接炭素上であ り、ヘテロアリール基としては例えば前記の含窒素ヘテ ロ環誘導体を含有する基、チエニル基、フリル基などが 挙げられる)、7、8ーベンゾキノリン誘導体、ホスフ ィノアリール誘導体、ホスフィノヘテロアリール誘導・ 体、ホスフィノキシアリール誘導体、ホスフィノキシへ テロアリール誘導体、アミノメチルアリール誘導体、ア ミノメチルヘテロアリール誘導体等が挙げられる。アリ ール基置換含窒素芳香族ヘテロ環誘導体、ヘテロアリー ル基置換含窒素芳香族ヘテロ環誘導体、7、8-ベンゾ キノリン誘導体が好ましく、フェニルビリジン誘導体、 チエニルビリジン誘導体、7.8-ベンゾキノリン誘導 体、ベンジルピリジン誘導体、フェニルピラゾール誘導 体、フェニルイソキノリン誘導体、窒素原子を2つ以上 有するアゾールのフェニル置換誘導体がさらに好まし く、チエニルビリジン誘導体、7,8-ベンゾキノリン 誘導体、ベンジルピリジン誘導体、フェニルピラゾール 誘導体、フェニルイソキノリン誘導体、窒素原子を2つ の有機化合物薄層を形成した発光素子において、少なく 50 以上有するアゾールのフェニル置換誘導体が特に好まし

【0034】本発明の化合物は、オルトメタル化錯体を 形成するに必要な配位子以外に、他の配位子を有してい ても良い。他の配位子としては種々の公知の配位子が有 るが、例えば、「Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds; Springer-Verlag社 H. Yersi n著 1987年発行、「有機金属化学-基礎と応用-」 裳華房社 山本明夫著 1982年発行 等に記載の配位 子が挙げられ、好ましくは、ハロゲン配位子 (好ましく は塩素配位子)、含窒素ヘテロ環配位子(例えばビビリ 10 ジル、フェナントロリンなど)、ジケトン配位子であ り、より好ましくは塩素配位子、ビビリジル配位子であ る。

【0035】本発明の化合物の配位子の種類は1種類で も良いし、複数の種類があっても良い。錯体中の配位子 の数は好ましくは1~3種類であり、特に好ましくは 1、2種類であり、さらに好ましくは1種類である。 【0036】本発明の化合物の炭素数は、好ましくは5 ~100、より好ましくは10~80、さらに好ましく は14~50である。

【0037】本発明の一般式(1)ないし(10)で表 される部分構造を有する化合物またはその互変異性体の うち、一般式(1)、(2)、(4)ないし(10)で 表される部分構造を有する化合物またはその互変異性体 がより好ましい。

【0038】一般式(1)で表される部分構造を有する 化合物またはその互変異性体は、化合物中にイリジウム 原子を一つ有しても良いし、また、2つ以上有するいわ ゆる複核錯体であっても良い。他の金属原子を同時に含 れる部分構造を有する化合物またはその互変異性体も同

【0039】一般式(3)において、R1、R1は置換基 を表す。q¹, q²は0~4の整数を表し、かつ、q¹+ q² は1以上である。q¹、q²が2以上の場合、複数個 のR1, R2はそれぞれ同一または互いに異なっても良 い。R1, R2としては、例えば、アルキル基 (好ましく は炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特 に好ましくは炭素数1~10であり、例えばメチル、エ チル、iso-プロピル、tert-ブチル、n-オク 40 チル、n-デシル、n-ヘキサデシル、シクロプロピ ル、シクロペンチル、シクロヘキシル、トリフルオロメ チル基、ペンタフルオロエチル基などが挙げられ る。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~30、よ り好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2 ~10であり、例えばビニル、アリル、2-ブテニル、 3-ペンテニルなどが挙げられる。)、アルキニル基 (好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数2 ~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えば プロパルギル、3ーペンチニルなどが挙げられる。)、

アリール基 (好ましくは炭素数6~30、より好ましく は炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~12であ り、例えばフェニル、pーメチルフェニル、ナフチル、 アントラニルなどが挙げられる。)、アミノ基(好まし くは炭素数0~30、より好ましくは炭素数0~20、 特に好ましくは炭素数0~10であり、例えばアミノ、 メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジベ ンジルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノなど が挙げられる。)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1 ~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましく は炭素数1~10であり、例えばメトキシ、エトキシ、 ブトキシ、2-エチルヘキシロキシなどが挙げられ る。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~3 0、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭 素数6~12であり、例えばフェニルオキシ、1-ナフ チルオキシ、2ーナフチルオキシなどが挙げられ る。)、ヘテロアリールオキシ基(好ましくは炭素数1 ~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましく は炭素数1~12であり、例えばピリジルオキシ、ピラ ジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが 挙げられる。)、アシル基(好ましくは炭素数1~3 0、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭 素数1~12であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホ ルミル、ピバロイルなどが挙げられる。)、アルコキシ カルポニル基 (好ましくは炭素数 2~30、より好まし くは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~12で あり、例えばメトキシカルポニル、エトキシカルボニル などが挙げられる。)、アリールオキシカルボニル基 (好ましくは炭素数7~30、より好ましくは炭素数7 有していても良い。一般式(2)ないし(10)で表さ 30 ~20、特に好ましくは炭素数7~12であり、例えば フェニルオキシカルボニルなどが挙げられる。)、アシ ルオキシ基(好ましくは炭素数2~30、より好ましく は炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10であ り、例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げら れる。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~3 0、より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭 素数2~10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイ ルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニル アミノ基(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは 炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~12であ り、例えばメトキシカルポニルアミノなどが挙げられ る。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましく は炭素数7~30、より好ましくは炭素数7~20、特 に好ましくは炭素数7~12であり、例えばフェニルオ キシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、スルホニ ルアミノ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばメタンスルホニルアミノ、ベンゼンスルホニ ルアミノなどが挙げられる。)、スルファモイル基(好 50 ましくは炭素数0~30、より好ましくは炭素数0~2

12 .

0、特に好ましくは炭素数0~12であり、例えばスル ファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファ モイル、フェニルスルファモイルなどが挙げられ る。)、カルバモイル基(好ましくは炭素数1~30、 より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数 1~12であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモ イル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルな どが挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭素 数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ま しくは炭素数1~12であり、例えばメチルチオ、エチ 10 ルチオなどが挙げられる。)、アリールチオ基(好まし くは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、 特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニル チオなどが挙げられる。)、ヘテロアリールチオ基(好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばピリ ジルチオ、2ーベンズイミゾリルチオ、2ーベンズオキ サゾリルチオ、2-ベンズチアゾリルチオなどが挙げら れる。)、スルホニル基(好ましくは炭素数1~30、 より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数 20 1~12であり、例えばメシル、トシルなどが挙げられ る。)、スルフィニル基(好ましくは炭素数1~30、 より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数 1~12であり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼン スルフィニルなどが挙げられる。)、ウレイド基(好ま しくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばウレ イド、メチルウレイド、フェニルウレイドなどが挙げら れる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~3 0、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭 30 素数1~12であり、例えばジエチルリン酸アミド、フ ェニルリン酸アミドなどが挙げられる。)、ヒドロキシ 基。メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、 塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ 基、カルポキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、ス ルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基 (好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~1 2であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素 原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダブリル、ピリ ジル、キノリル、フリル、チエニル、ピペリジル、モル 40 ホリノ、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベ ンズチアゾリルなどが挙げられる。)、シリル基(好ま しくは炭素数3~40、より好ましくは炭素数3~3 0、特に好ましくは炭素数3~24であり、例えばトリ メチルシリル、トリフェニルシリルなどが挙げられ る。) などが挙げられる。これらの置換基は更に置換さ れてもよい。また、R1基どうし、R2基どうし、もしく は、R1基,R2基が結合して循環構造を形成しても良

コキシ基、アミノ基、シアノ基、結合して縮環構造を形成する基が好ましく、アルキル基、結合して芳香族縮環構造を形成する基がより好ましい。 \mathbf{q}^1 , \mathbf{q}^2 は $\mathbf{0}$, $\mathbf{1}$, $\mathbf{2}$ が好ましく、より好ましくは \mathbf{q}^1 + \mathbf{q}^2 = $\mathbf{1}$ or $\mathbf{2}$ である。

【0041】一般式(4)において、Z¹¹およびZ¹²は5員環または6員環を形成するのに必要な非金属原子団を表し、この環は置換基を有していても良く、またさらに別の環と紹合環を形成していてもよい。置換基としては例えばハロゲン原子、脂肪族基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ、ニトロ、一OR¹⁰¹、一SR¹⁰²、一COR¹⁰³、一OCOR¹⁰⁴、一NR¹⁰⁵R¹⁰⁶、一CONR¹⁰⁷R¹⁰⁸、一SO₂R¹⁰⁹、一SO₂NR¹¹⁰R¹¹¹、一NR¹¹²CONR¹¹³R¹¹⁴、一NR¹¹⁵CO₂R¹¹⁶、一COR¹¹⁷、一NR¹¹⁸COR¹¹⁹または一NR¹²⁰SO₂R¹²¹が挙げられる。ここでR¹⁰¹、R¹⁰²、R¹⁰³、R¹⁰⁴、R¹⁰⁵、R¹⁰⁶、R¹⁰⁷、R¹⁰⁸、R¹⁰⁸、R¹¹⁰、R¹¹¹、R¹¹²、R¹¹³、R¹¹⁴、R¹¹⁵、R¹¹⁶、R¹¹⁷、R¹¹⁸、R¹¹⁹、R¹²⁰およびR¹²¹はそれぞれ独立に、水素原子、脂肪族基またはアリール基である。

【0042】 置換基としては上記のうちハロゲン原子、 脂肪族基、アリール基、一〇R¹⁰¹、一 SR¹⁰²、一NR ¹⁰⁵R¹⁰⁶、一 SO₂R¹⁰⁹、一 NR¹¹²CONR ¹¹³R¹¹⁴、一 NR¹¹⁵CO₂R¹¹⁶、一 NR¹¹⁸COR¹¹⁹ または一 NR¹²⁰SO₂R¹²¹であることが好ましく、ハロゲン原子、脂肪族基、アリール基、一〇R¹⁰¹、一 S R¹⁰²、一 NR¹⁰⁵R¹⁰⁶またはで一 SO₂R¹⁰⁹あることがより好ましく、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、フェノキシ基、ジアルキルアミノ基であることがより好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数 1~10のアルキル基、炭素原子数6~10のアリール基、炭素原子数1~10のアルコキシ基であることがさらに好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数1~4のアルコキシ基であることがおらに好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数1~4のアルキル基であることが最も好ましい。

【0043】ここで、脂肪族基はアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基を意味する。

ピラゾール環、1,2,3-トリアゾール環、1,2,4-トリアゾール環、ピリジン環およびピリミジン環が好ましく、イミダゾール環、チアゾール環、ピロール環、ピラゾール環、ピリジン環およびピリミジン環がさらに好ましく、ピラゾール環およびピリジン環が更に好ましい。好ましい乙¹¹、乙¹²の炭素原子数は各々3~40であり、さらに好ましくは3~30であり、特に好ましくは3~20である。

【0045】 Ln1は2個の基を表わす。2個の基とし ては例えばーC(R¹³¹ 〉(R¹³²)-_、-N(R¹³³) -、-O-、-P(R134)-または-S-が挙げられ る。ここでR131およびR132はそれぞれ独立に水業原 子、ハロゲン原子、脂肪族基、アリール基、ヘテロ環 基、シアノ、-OR¹⁴¹、-SR¹⁴²、-CO₂R¹⁴³、-OCOR144, -NR145R146, -CONR147R148, -SO2R149, -SO2NR150R151, -NR152CON · R153 R154 , -NR155 CO2 R156 , -COR157 , -N R¹⁵⁸COR¹⁶⁹または-NR¹⁶⁰SO₂R¹⁵¹を表わし、 R141, R142, R143, R144, R145, R146, R147, R148 R149 R150 R151 R152 R153 R154 R155, R156, R167, R168, R159, R160 BLUR 161はそれぞれ独立に、水素原子、脂肪族基またはアリ ール基である。R133は脂肪族基、アリール基またはへ テロ環基を表わし、またR134は脂肪族基、アリール 基、ヘテロ環基および一OR171を表わし、 R171は水 素原子、脂肪族基またはアリール基である。

【0046】L n^1 として好ましくは-C(R^{131})(R^{132})-、-O—または-S—であり、さらに好ましくは-C(R^{131})(R^{132})-で R^{131} および R^{132} が水素原子、脂肪族基またはアリール基の場合であり、さらに 30 好ましくは-C(R^{131})(R^{132})-で R^{131} および R^{132} が水素原子あるいは炭素数 $1\sim4$ のアルキル基の場合である。好ましいL n^1 の炭素原子数は $0\sim2$ 0であり、さらに好ましくは $0\sim1$ 0である。

【0047】Y¹は窒素原子または炭素原子を表わす。 Y¹が窒素原子のときb¹は単結合を表わし、炭素原子のときb¹は二重結合を表わす。

【0048】一般式(7)においてZ²¹およびZ²²は5 員環または6員環を形成するのに必要な非金属原子団を 40 表わし、この環は置換基を有していても良く、また更に 別の環と縮合環を形成してもよい。置換基の例としては ハロゲン原子、脂肪族基、アリール基、ヘテロ環基、シ アノ、ニトロ、…OR²⁰¹、…SR²⁰²、—CO₂R²⁰³、 —OCOR²⁰⁴、—NR²⁰⁵R²⁰⁶、—CONR ²⁰⁷R²⁰⁸、—SO₂R²⁰⁹、—SO₂NR²¹⁰R²¹¹、—N R²¹²CONR²¹³R²¹⁴、—NR²¹⁵CO₂R²¹⁶、—CO R²¹⁷、—NR²¹⁸COR²¹⁹または—NR²²⁰SO₂R²²¹ が挙げられる。ここでR²⁰¹、R²⁰²、R²⁰³、R²⁰⁴、R ²⁰⁵、—R²⁰⁶、R²⁰⁷、R²⁰⁶、R²⁰⁹、R²¹⁰、R²¹¹、R 212, R213, R214, R215, R216, R217, R218, R

²¹⁹、R²²⁰およびR²²¹はそれぞれ独立に、水素原子、 脂肪族基またはアリール基である。

【0049】 Z^{21} および Z^{22} の好ましい置換基として挙げられるものは、 Z^{11} および Z^{12} の場合と全く同じであ

【0050】Z21が形成する5員環、6員環としてはフ ラン環、チオフェン環、イミダゾール環、チアゾール 環、オキサゾール環、ピロール環、ピラゾール環、1. 10 2, 3-トリアゾール環、1, 2, 4-トリアゾール 環、セレナゾール環、オキサジアゾール環、チアジアゾ ール環、ベンゼン環、ピリジン環、ピリミジン環、ピラ ジン環およびピリダジン環がある。これらのうち、チオ フェン環、イミダゾール環、チアゾール環、オキサゾー ル環、ピロール環、ピラゾール環、ベンゼン環およびピ リジン環が好ましく、チアゾール環、ピロール環、ベン ゼン環およびビリジン環が更に好ましく、ベンゼン環が、 最も好ましい。Z22としてはピラゾール環、1、2、3 ートリアゾール環、1,2,4-トリアゾール環および 20 ピリダジン環があり、ピラゾール環が最も好ましい。好 ましいZ¹¹、Z¹²の炭素原子数は各々3~40であり、 さらに好ましくは3~30であり、特に好ましくは3~ 20である。

【0051】Y²は窒素原子または炭素原子を表わす。 Y²が窒素原子のとき b²は単結合を表わし、炭素原子の とき b²は二重結合を表わす。

【0052】一般式(8)において、式中、X201、X ²⁰²、X²⁰³およびX²⁰⁴は、窒素原子またはC-Rを表 し、-C=N-とともに含窒素へテロアリール6冒環を 形成し、X²⁰¹、X²⁰²、X²⁰³およびX²⁰⁴の少なくとも 1つは窒素原子を表す。X201、X202、X203、X204が -C=N-とともに形成する含窒素へテロアリール6員 環は縮環を形成しても良い。Rは水素原子または置換基 を表し、置換基としてはR1、R2において説明したもの。 と同義である。好ましくはピラジン、ピリミジン、ピリ グジン、トリアジン、キノキサリン、キナゾリン、フタ ラジン、シンノリン、プリン、プテリジン等を表し、さ らに好ましくはピラジン、ピリミジン、ピリダジン、キ ノキサリン、キナゾリン、フタラジン、シンノリンを表 す。 2201 はアリール環またはヘテロアリール環を形成 する原子団を表す。2201が形成するアリール環は、好 ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~2 0、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェ ニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル 基、ビレニル基などが挙げられ、さらに炭素環、ヘテロ 環と縮環を形成しても良い。Z201が表すヘテロアリー ル環は好ましくは炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄 原子からなるヘテロアリール環を表し、さらに好ましく は5ないし6員のヘテロアリール環を表し、さらに縮環 50 を形成しても良く、好ましくは炭素数2~30、より好

ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~1 0であり、例えばピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピ リダジン、キノリン、イソキノリン、キノキサリン、フ タラジン、キナゾリン、ナフトリジン、シンノリン、ペ リミジン、フェナントロリン、ピロール、イミダゾー ル、ピラゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、ト リアゾール、チアジアゾール、ベンズイミダゾール、ベ ンズオキサゾール、ペンズチアゾール、フェナントリジ ン、チエニル基、フリル基などが挙げられる。Z201が 形成する環はアリール環が好ましい。

【0053】一般式(9)において、Z201は一般式 (8)と同義であり、2301はピリジン環に縮環するア リール環またはヘテロアリール環を形成する原子団を表 し、形成するアリール環、ヘテロアリール環は一般式 (8) の2201が形成するアリール環、ヘテロアリール 環と同様である。 2301が形成する環はアリール環が好 *

一般式 (11)

一般式 (13)

$$(R^{31})_{q31}$$
 $k - (L^2)_{n3}$
 $(R^{32})_{q32}$

*ましい。

【0054】一般式(10)において、Z201は一般式 (8)と同義であり、Z101はピリジン環に縮環するア リール環またはヘテロアリール環を形成する原子団を表 し、形成するアリール環、ヘテロアリール環は一般式 (8)の2201が形成するアリール環、ヘテロアリール 環と同様である。Zf01が形成する環はアリール環が好

【0055】本発明の化合物のさらに好ましい形態は、 10 一般式(11)ないし一般式(20)で表される化合物 である。一般式(11)ないし(12)で表される化合 物および一般式(14)ないし一般式(20)で表され る化合物が特に好ましい。

[0056] 【化21】

一般式 (12)

$$(R^{21})_{q21}$$
 $(R^{21})_{q21}$
 $(R^{21})_{m2}$
 $(R^{21})_{m2}$

[0057] 【化22】

1.8

17 一般式 (14) (R³⁰¹)_{q301} I (L¹⁰¹)_{n101} (R³⁰²)_{q302}

一般式(15) (CO)_{m102}h(L¹⁰²)_{n102}

一般式(16) (NC)_{m103}h(L¹⁰³)_{m103}

一般式 (17)

【0058】 【化23】 一般式(18)

一般式(19)

【0059】一般式(11)について説明する。 R^{11} 、 R^{12} は置換基を表し、置換基としては前記 R^{1} で説明した置換基が挙げられる。

【0060】R¹¹, R¹²はアルキル基、アリール基が好ましく、アルキル基がより好ましい。

【0061】 q^{11} は0~2の整数を表し、0.1が好ましく、0がより好ましい。 q^{12} は0~4の整数を表し、0.1が好ましく、0がより好ましい。 q^{11} , q^{12} が2以上の場合、複数個の R^{11} , R^{12} はそれぞれ同一または互いに異なっても良く、また、連結して循環を形成しても良い。

【0062】L'は配位子を表す。配位子としては前記 10 オルトメタル化イリジウム錯体を形成するに必要な配位 子、及び、その他の配位子で説明した配位子が挙げられ る。L'はオルトメタル化イリジウム錯体を形成するに 必要な配位子、含窒素へテロ環配位子、ジケトン配位 子、ハロゲン配位子が好ましく、より好ましくはオルト メタル化イリジウム錯体を形成するに必要な配位子、ビ ビリジル配位子である。

【0063】n¹は0~5を表し、0が好ましい。m¹は 1,2,3を表し、好ましく3である。n¹,m¹の数 の組み合わせは、一般式(4)で表される金属錯体が中 20 性錯体となる数の組み合わせが好ましい。

【0064】一般式 (12) について説明する。 R^{21} , n^2 , m^2 , L^2 はそれぞれ前記 R^{11} , n^1 , m^1 , L^1 とそれぞれ同義である。 q^{21} は0~8を表し、0が好ましい。 q^{21} が2以上の場合は、複数個の R^{21} は同一まだは互いに異なっても良く、また、連結して縮環を形成しても良い。

【0065】一般式(13)について説明する。R³¹、R³²、q³¹、q³²、n³、m³、L³はそれぞれ前記R¹、R²、q¹、q²、n¹、m¹、L¹とそれぞれ同義である。 30 【0066】一般式(14)について説明する。

 R^{301} 、 R^{302} は置換基を表わし、置換基とは Z^{11} および Z^{12} にて説明したものと同義である。 q^{301} 、 q^{302} は Q^{302} は Q^{303} 、 Q^{304} に Q^{305} に $Q^$

【0067】一般式(15)について説明する。 L^{102} は前記 L^1 と同義であり、 n^{102} は $0\sim5$ の整数を表わし、 $1\sim5$ が好ましい。 m^{102} は $1\sim6$ の整数を表わし、1および2が好ましい。 n^{102} と m^{102} の数の組み合わせは一般式(15)で表わされる金属錯体が中性錯体となる数の組み合わせが好ましい。

【0068】一般式(16)について説明する。 L¹⁰³、n¹⁰³、m¹⁰³はそれぞれL¹、n¹⁰²、m¹⁰²と同義である。

【0069】一般式(17)について説明する。R³⁰³ は置換基を表わし、置換基とはZ²¹にて説明したものと 同義である。Z²³、q³⁰³、L¹⁰⁴、n¹⁰⁴、m¹⁰⁴はそれ 50 ぞれ前記Z²²、q³⁰¹、L¹、n¹⁰¹、m¹⁰¹と同義であ

る。

【0070】一般式(18)について説明する。一般式(18)において、X²⁰¹、X²⁰²、X²⁰³およびX²⁰⁴が一C=N-とともに形成する環は、一般式(8)で説明したものと同様であり、好ましい範囲も同様である。 Z²⁰¹はアリール環またはヘテロアリール環を形成する原子団を表し、一般式(8)で説明したものと同様であり、好ましい範囲も同様である。 n²⁰¹, m²⁰¹, L²⁰¹はそれぞれ前記 n¹, m¹, L¹とそれぞれ同義である。 (0071】一般式(19)において、Z²⁰¹、Z³⁰¹は 10一般式(9)で説明したものと同様であり、好ましい範囲も同様である。 n²⁰², m²⁰², L²⁰²はそれぞれ前記 n¹, m¹, L¹とそれぞれ同義である。

19

【0072】一般式(20)において、Z²⁰¹、Z⁴⁰¹は 一般式(10)で説明したものと同様であり、好ましい 範囲も同様である。n²⁰⁸, m²⁰³, L²⁰³はそれぞれ前 記n¹, m¹, L¹とそれぞれ同義である。

【0073】本発明の化合物は一般式(1)等の繰り返し単位をひとつ有する、いわゆる低分子化合物であっても良く、また、一般式(1)等の繰り返し単位を複数個 20 有するいわゆる、オリゴマー化合物、ボリマー化合物(重量平均分子量(ボリスチレン換算)は好ましくは1000~5000000、より好ましくは2000~100000である。)であっても良い。本発明の化合物は低分子化合物が好ましい。

【0074】次に本発明に用いる化合物例を示すが、本発明はこれに限定されない。

[0075]

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & \end{pmatrix} \end{pmatrix}_{2} \qquad \begin{pmatrix} C \\ 0 & \end{pmatrix} \end{pmatrix}_{2}$$

$$\begin{pmatrix} 1-3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1-4 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1-$$

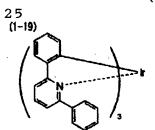
【0076】 【化25】

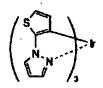
[0077]

* *【化26】

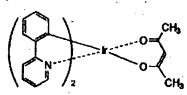
[0078]

*【化27】

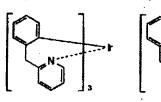




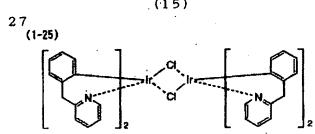
(1-22)

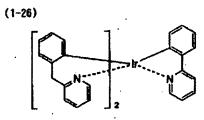


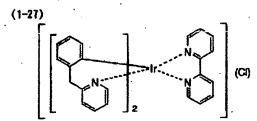
(1-23)

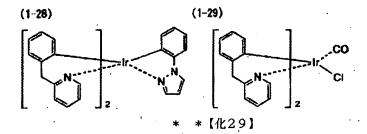


[0079]





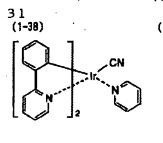


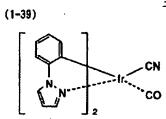


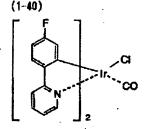
[0080]

[0081]

30【化30】







[0082]

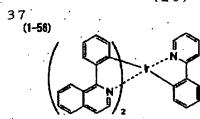
*【化31】

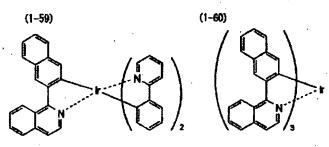
【0083】 【化32】

30

[0084] 【化33】

10





[0085]

*【化34】

[0086] 【化35】

(1-70)

42

号,1685頁.,同1988,27号,3464頁.,同1994年,33号,545 頁., Inorg.Chem.Acta 1991年,181号,245頁., J.Organ omet.Chem. 1987年,335号,293頁., J.Am.Chem.Soc.19 85年,107号,1431頁等、種々の公知の手法で合成するこ とができる。

【0088】本発明化合物の合成例の一部を以下に示 *

* す。以下に示すとおり、6ハロゲン化イリジウム (II I) 化合物、6ハロゲン化イリジウム (IV) 化合物を出 発原料にして合成することもできる。

【0089】 【化36】

$$(L)_2$$
 CH_3 CH_3 CH_3

【0090】(合成例1)

・例示化合物 (1-25) の合成

3ツロフラスコにK3 I r C 16を5.22g、2-ベンジルピリジンを16.9g、グリセロール50m1を入れ、アルゴン雰囲気下にて内温を200℃に加熱しなが2061時間撹拌した。この後内温が40℃になるまで冷却し、メタノール150m1を添加した。そのまま1時間撹拌した後、吸引評過して得られた結晶をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、目的の例示化合物(1-25)を4.34g得た(収率77%)。

【0091】(合成例2)

・例示化合物(1-24)の合成
3ツロフラスコに例示化合物(1-25)を5.64
g、クロロホルム560ml、アセチルアセトン10.0gを入れて、室温にて撹拌しながらここへナトリウム、30メチラートの28%メタノール溶液20.1mlを20分かけて満下した。満下終了後室温にて5時間撹拌した後、飽和食塩水40ml、水400mlを添加し、抽出した。得られたクロロホルム層を飽和食塩水300mlと水30mlの混合溶液で4回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ロータリーエバボレーターで濃縮した。こうして得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトフラフィーで精製して目的の例示化合物(1-24)

【0092】(合成例3)

・例示化合物(1-26)の合成

を5,59g得た(収率89%)。

3ツロフラスコに例示化合物(1-24)を6.28 ※

※g、2-フェニルビリジンを15.5g、グリセロールを63m1入れ、アルゴン雰囲気下にて内温を170℃に加熱しながら15分間撹拌した。この後内温が40℃になるまで冷却し、クロロホルム500m1、飽和食塩が40m1、水400m1を添加して抽出した。得られたクロロホルム層を飽和食塩水40m1と水400m1の混合液で4回洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。このものをロータリーエバボレーターで濃縮して得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、目的の例示化合物(1-26)を5.60g得た(収率82%)。

【0093】(合成例4)

・例示化合物(1-29)の合成

3ツロフラスコに例示化合物(1-25)5.64g、クロロホルム560mlを入れ、水浴下にて攪拌しながらここへ一酸化炭素を10分間吹き込んだ。この後撹拌を1時間続けた後、飽和食塩水40ml、水400mlを添加し、抽出した。得られたクロロホルム層を飽和食塩水300mlと水30mlの混合溶液で4回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ロータリーエバボレーターで濃縮した。こうして得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトフラフィーで特製して目的の例示化合物(1-29)を4.38g得た(収率74%)。【0094】(合成例5)

40 例示化合物 (1-65) および (1-66) の合成 【0095】 【化37】

【0096】KalrCls1.35gを水25mlに溶 解したものに3-クロロー6-フェニルビリダジン1. 01gとグリセリン100m1添加し、180℃にて4 時間加熱撹拌した。反応終了後、放冷し、水を添加し、 析出したこげ茶色固体を沪取、乾燥した。次に得られた セトン2.5gと28%ナトリウムメトキシドメタノー ル溶液4.8gを添加し、加熱湿流下、2時間反応し た。反応終了後、水500mlに注ぎ、クロロホルムで 抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥後濃縮 し、得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィ にて展開した。はじめに溶出した橙色フラクションを濃 縮し、クロロホルムーエタノールにて再結晶、乾燥し、 目的の例示化合物1-65を66mg得た。本化合物の 溶液蛍光スペクトルを測定したところ、蛍光の入max =578nm(CHCl₃)であった。更に次に溶出し た赤橙色フラクションを濃縮し、クロロホルムーエタノ ールにて再結晶、乾燥し、目的の例示化合物1…66を 204 mg得た、本化合物の溶液蛍光スペクトルを測定 したところ、蛍光の入max=625nm (CHC .13)であった。

【0097】次に、本発明の化合物を含有する発光案子 に関して説明する。本発明の発光素子は、本発明の化合 物を利用する素子であればシステム、駆動方法、利用形 腿など特に問わないが、本発明の化合物からの発光を利 用するもの、または本化合物を電荷輸送材料として利用 40 する物が好ましい。代表的な発光素子として有機EL (エレクトロルミネッセンス) 素子を挙げることができ る.

【0098】本発明の化合物を含有する発光素子の有機 層の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗 加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子積層法、 コーティング法、インクジェット法、印刷法などの方法 が用いられ、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着、コーティ ング法が好ましく、また、蒸着時の熱分解回避の点か ら、コーティング法がより好ましい。

*【0099】本発明の発光素子は隠極、陰極の一対の電 極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄 膜を形成した素子であり、発光層のほか正孔注入層、正 孔翰送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などを有し てもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備え 固体をクロロホルム1Lに溶解したものに、アセチルア 20 たものであってもよい。各層の形成にはそれぞれ種々の 材料を用いることができる。

> 【0100】陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層な どに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物などを用 いることができ、好ましくは仕事関数が4 e V以上の材 料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化イ ンジウム、酸化インジウムスズ(I-TO)等の導電性金 **属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金** 属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物 または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物 質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなど の有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物な どが挙げられ、好ましくは、導雲性金属酸化物であり、 特に、生産性、高薄電性、透明性等の点からITOが好 ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能である が、通常10nm~5µmの範囲のものが好ましく、よ り好ましくは50nm~1µmであり、更に好ましくは 100nm~500nmである。

【0101】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機 械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガ ラスを用いる場合には、通常O.2mm以上、好ましく は0.7mm以上のものを用いる。隔極の作製には材料 によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場

*50 合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着

法、化学反応法(ゾルーゲル法など)、酸化インジウム スズの分散物の塗布などの方法で膜形成される。陽極は 洗浄その他の処理により、素子の駆動電圧を下げたり、 発光効率を高めることも可能である。例えばITOの場 合、UVーオゾン処理、プラズマ処理などが効果的であ る

【0102】陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層な どに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送 層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイオン 化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰極の 材料としては金属、合金、金属ハロゲン化物、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用いる ことができ、具体例としてはアルカリ金属(例えばし i、Na、K等)及びそのフッ化物、アルカリ土類金属 (例えばMg、Ca等)及びそのフッ化物、金、銀、 鉛、アルミニウム、ナトリウムーカリウム合金またはそ れらの混合金属、リチウムーアルミニウム合金またはそ れらの混合金属、マグネシウムー銀合金またはそれらの 混合金属、インジウム、イッテリビウム等の希土類金属 等が挙げられ、好ましくは仕事関数が4 e V以下の材料 であり、より好ましくはアルミニウム、リチウムーアル ミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウムー 銀合金またはそれらの混合金属等である。陰極は、上記 化合物及び混合物の単層構造だけでなく、上記化合物及 び混合物を含む積層構造を取ることもできる。陰極の膜 厚は材料により適宜選択可能であるが、通常10 nm~ 5 μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは50 n m~1μmであり、更に好ましくは100nm~1μm である。陰極の作製には電子ビーム法、スパッタリング 法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方法が用い 30 られ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を同時 に蒸着することもできる。さらに、複数の金属を同時に 蒸煮して合金電極を形成することも可能であり、またあ らかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。陽極及び陰 極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百Ω╱□以下が 好ましい。

「0103】発光層の材料は、電界印加時に陽極または 正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することができると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を 注入することができる機能や、注入された電荷を移動さ せる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させ る機能を有する層を形成することができるものであれば 何でもよく、一重項励起子または三重項励起子のいずれ から発光するものであっても良い。例えばベンゾオキサ ゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ベンゾチア ゾール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ボリフェニル ブタジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ペリノン誘導体、カマリンン誘導体、カマリンン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ペリノン誘導体、カマリン対スール、ボリステル、ボリフェニレンオキシド、ボリブタジエン、ボ

クロペンタジエン誘導体、ピススチリルアントラセン誘 導体、キナクリドン誘導体、ピロロピリジン誘導体、チ アジアゾロビリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導 体、スチリルアミン誘導体、芳香族ジメチリディン化合 物、8-キノリノール誘導体の金属錯体や希土類錯体に 代表される各種金属錯体等、ポリチオフェン、ポリフェ ニレン、ポリフェニレンピニレン等のポリマー化合物、 有機シラン誘導体、本発明の化合物等が挙げられる。発 光層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1ヵ m~5µmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 nm~1µmであり、更に好ましくは10nm~500 nmである。発光層の形成方法は、特に限定されるもの ではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリン グ、分子積層法、コーティング法(スピンコート法、キ ャスト法、ディップコート法など)、インクジェット 法、LB法、印刷法などの方法が用いられ、好ましくは 抵抗加熱蒸着、コーティング法である。

【0104】正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極か ら正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から 注入された電子を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、カルバゾール誘 導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキ サジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリー ルアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導 体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導 体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン 誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチ ルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化 合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系 化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、 ポリ(Nービニルカルバゾール)誘導体、アニリン系共 重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導 電性高分子オリゴマー、有機シラン誘導体、カーボン 膜、本発明の化合物等が挙げられる。正孔注入層、正孔 輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1 nm~5μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは 5 nm~1 μmであり、更に好ましくは10 nm~50 Onmである。正孔注入層、正孔輸送層は上述した材料 の1種または2種以上からなる単層構造であってもよい し、同一組成または異種組成の複数層からなる多層構造 であってもよい。正孔注入層、正孔輸送層の形成方法と しては、真空蒸着法やLB法、前記正孔注入輸送剤を溶 媒に溶解または分散させてコーティングする方法(スピ ンコート法、キャスト法、ディップコート法など)、イ ンクジェット法、印刷法が用いられる。コーティング法 の場合、樹脂成分と共に溶解または分散することがで き、樹脂成分としては例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカ ーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレー ト、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリス

リ(Nービニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン 樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロー ス、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン 樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキ シ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。

【0105】電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極か ら電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から 注入された正孔を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、トリアゾール辞 導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、 フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、ア ントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピラン ジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニ リデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフ タレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、フ タロシアニン誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯 体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベン ゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各種 金属錯体、有機シラン誘導体等が挙げられる。電子注入 層、電子輸送層の膜厚は特に限定されるものではない が、通常1nm~5µmの範囲のものが好ましく、より 好ましくは $5nm\sim1\mu m$ であり、更に好ましくは10nm~500nmである。電子注入層、電子輸送層は上 述した材料の1種または2種以上からなる単層構造であ ってもよいし、同一組成または異種組成の複数層からな る多層構造であってもよい。電子注入層、電子輸送層の 形成方法としては、真空蒸着法やLB法、前記電子注入 輸送剤を溶媒に溶解または分散させてコーティングする 方法(スピンコート法、キャスト法、ディップコート法 **・など)、インクジェット法、印刷法などが用いられる。** コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解または分散 することができ、樹脂成分としては例えば、正孔注入輸 送層の場合に例示したものが適用できる。

【0106】保護層の材料としては水分や酸素等の素子 劣化を促進するものが案子内に入ることを抑止する機能 を有しているものであればよい。その具体例としては、 In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, Ti, N i等の金属、MgO、SiO、SiO2、Al2O3、G eO, NiO, CaO, BaO, Fe₂O₃, Y₂O₃, T iO2等の金属酸化物、MgF2、LiF、AJF3、C aF2等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレ ン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレ ア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフル オロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロ ロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレン との共重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1 種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて 得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フ ッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率

成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、MBE (分子線エピタキシ)法、クラスターイオンピーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コーテ

48

[0107]

【実施例】以下に本発明の具体的実施例を述べるが、本 発明の実施の態様はこれらに限定されない。

【0108】比較例1

ィング法、印刷法を適用できる。

ポリ(Nービニルカルバゾール)40mg、PBD(2 -(4-ピフェニル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール) 12mg、化合物A 1mgをジクロロエタン2.5mlに溶解し、洗浄した 基板上にスピンコートした (1500 rpm, 20 se c)、有機層の膜厚は98nmであった。有機薄膜上に パターニングしたマスク(発光面積が4mm×5mmと なるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀 20 = 10:1を50nm共素着した後、銀50nmを蒸着 した。東陽テクニカ製ソースメジャーユニット2400 型を用いて、直流定電圧をEL素子に印加し発光させ、 その輝度をトプコン社の輝度計BM-8、発光波長を浜 松フォトニクス社製スペクトルアナライザーPMA-1 1を用いて測定した。その結果、発光のAmax=50 Onmの緑色発光が得られた。100cd/m²付近で の外部量子収率を算出したところ 0.1%であった。 **窒素下1時間放置したところ、発光面に多数のダークス** ボットが目視された。

30 [0109]

【化38】

化合物

【0110】実施例1

比較例1の化合物Aの替わりに(1-1)を用い、比較例1と同様に素子作製した。発光のAmax=510nmの緑色の発光が得られ、100cd/m²付近での外部量子収率は2.9%であった。窒素下1時間放置したところ、発光面に少量のダークスポットが目視された。実施例2

比較例1の化合物Aの替わりに(1-2)を用い、比較例1と同様に素子作製した。発光のAmax=510nmの緑色の発光が得られた。窒素下1時間放置したがダークスポットは目視できなかった。

【0111】実施例3

得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フ 比較例1の化合物Aの替わりに(1-3)を用い、比較 ッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率 例1と同様に素子作製した。発光のAmax=590n 0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。保護層の形 50 m の橙色の発光が得られた。窒素下1時間放置したが ダークスポットは目視できなかった。

実施例4

比較例1の化合物Aの替わりに(1-4)を用い、比較例1と同様に素子作製した。発光のAmax=510nmの緑色の発光が得られた。窒素下1時間放置したがダークスポットは目視できなかった。

【0112】実施例5

比較例1の化合物Aの替わりに(1-20)を用い、比較例1と同様に紫子作成した。発光のAmax=547 nmの緑色の発光が得られた。窒素下1時間放置したが 10 ダークスポットは目視できなかった。

実施例6

比較例1の化合物Aの替わりに(1-24)を用い、比較例1と同様に素子作成した。発光のAmax=530 nmの緑色の発光が得られた。窒素下1時間放置したがダークスポットは目視できなかった。

【0.113】実施例7

比較例1の化合物Aの替わりに(1-25)を用い、比較例1と同様に素子作成した。発光のAmax=564 nmの発光が得られた。窒素下1時間放置したがダークスポットは目視できなかった。

実施例8

比較例1の化合物Aの替わりに(1-36)を用い、比較例1と同様に素子作成した。発光のAmax=520 nmの緑色の発光が得られた。窒素下1時間放置したがダークスポットは目視できなかった。

【0114】実施例9

比較例1の化合物Aの替わりに(1-41)を用い、比較例1と同様に素子作成した。発光のAmax=513 nmの緑色の発光が得られ、100cd/m²付近での外 30 部量子効率は5.1%であった。窒素下1時間放置したがダークスポットは目視できなかった。

実施例10

比較例1の化合物Aの替わりに(1-42)を用い、比較例1と同様に素子作製した。発光のAmax=535 nm の緑色の発光が得られた。窒素下1時間放置したがダークスポットは目視できなかった。

【0115】実施例11

比較例1の化合物Aの替わりに(1-44)を用い、比較例1と同様に素子作製した。発光のAmax=532 40 nm の橙色の発光が得られた。窒素下1時間放置したがダークスポットは目視できなかった。

実施例12

比較例1の化合物Aの替わりに(1-46)を用い、比較例1と同様に素子作製した。発光のAmax=568 nm の黄色発光が得られた。窒素下1時間放置したが ダークスポットは目視できなかった。

【0116】実施例13

比較例1の化合物Aの替わりに(1-65)を用い、比 発光のAmax=535nmの黄緑色発光が得られ、物例1と同様に素子作製した。発光のAmax=578 50 部量子効率3.1%(120cd/m²時)であった。

50 nm の黄橙色の発光が得られた。窒素下1時間放置し たがダークスポットは目視できなかった。

実施例14

比較例1の化合物Aの替わりに(1-66)を用い、比較例1と同様に素子作製した。発光の入max=625 nm の赤橙色の発光が得られた。窒素下1時間放置したがダークスポットは目視できなかった。

【0117】実施例15

洗浄した I TO基板を蒸着装置に入れ、 α -NPD (N, N'-ジフェニル-N, N'-ジ(α -ナフチル)-ベンジシン)を 40 nm蒸着し、この上に化合物 B, 本発明化合物 (1-46)を (10:1)の比率で 24 nm 共蒸着し、この上に、化合物Cを 24 nm 蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が 4 mm×5 mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を 250 nm 共蒸着した後、銀 250 nm を蒸着した。直流定電圧を E L 素子に印加し発光させた結果、発光の λ max=567 nmの黄色発光が得られ、外部量子効率 13.6% (185cd/ m^2 時)であった。

【0118】 【化39】

(化合物8)

(化合物C)

【0119】実施例16

洗浄した I TO基板を蒸着装置に入れ、α-NPD (N, N'ージフェニルーN, N'ージ (αーナフチル)ーペンジジン)を40nm蒸着し、この上に本発明化合物(1-42)を20nm共蒸着し、この上に、化合物Cを40nm蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が4mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を250nm共蒸着した後、銀250nmを蒸着した。直流定電圧をE L 素子に印加し発光させた結果、発光のλmax=535nmの黄緑色発光が得られ、外報量子が取る。1%(120cd/m²時)であった。

【0120】実施例17

ポリ (Nービニルカルバゾール) 40mg、PBD (2ー(4ーピフェニル)ー5ー(4ーtーブチルフェニル)ー1,3,4ーオキサジアゾール) 12mg、本発明化合物(1-49) 1mgをジクロロエタン2.5mlに溶解し、洗浄した基板上にスピンコートした(1500rpm,20sec)。有機層の膜厚は98nmであった。それを蒸着装置に入れ、有機膜上に、化合物Cを40nm蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が4mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でフッ化リチウムを5nm蒸着した後、アルミニウムを500nmを蒸着した。直流定電圧をEし素子に印加し発光させた結果、発光の入max=580nmの橙色発光が得られ、外部量子効率4.2%(1000cd/m²時)であった。

【0121】実施例18

Baytron P(PEDOT-PSS溶液(ポリエチレンジオキシチオフェンーポリスチレンスルホン酸ドープ体)/バイエル社製)を洗浄した基板上にスピンコートし(1000rpm, 30sec)、150℃にて1.5時間、真空乾燥した。有機層の膜厚は70nmであった。その上にポリ(Nービニルカルバゾール)40

mg、PBD (2-(4-ピフェニル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール)1 2mg、本発明化合物(1-42) 1mgをジクロロ エタン2.5mlに溶解し、洗浄した基板上にスピンコ ートした (1500 rpm, 20 sec)。 総有機層の 膜厚は170 nmであった。有機薄膜上にパターニング したマスク(発光面積が4mm×5mmとなるマスク) を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を 250nm共蒸着した後、銀250nmを蒸着した。直 10 流定電圧をEL素子に印加し発光させた結果、発光の入 max=540nmの黄緑色発光が得られ、外部量子効 率 6.2% (2000 c d/m²時) であった。 同様に 本発明の化合物含有EL案子を作製・評価したところ、 種々の発光色を有する高効率EL素子を作製でき、耐久 性に優れることが確認できた。また、本発明化合物を用 いた蒸着型ドープ素子高効率発光でき、発光材料を単層 膜にした素子においても、高効率発光可能である。

52

[0122]

ープ体) /バイエル社製) を洗浄した基板上にスピンコ 【発明の効果】本発明の化合物は有機EL用材料として ートし(1000 r p m, 30 s e c)、150℃にて 20 使用可能であり、また、種々の発光色を有する高効率、 1.5時間、真空乾燥した。有機層の膜厚は70 n mで 高耐久EL素子を作製できる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマニード(参考)
CO7D 213/28	·	C O 7 D 213/28	4065
213/68	•	213/68	4H050
213/84	·	213/84	•
217/02		217/02	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
221/10	,	221/10	
.231/42	1.00 A 55 L	231/12	C ₂ , , , ,
237/12		237/12	
241/16		241/16	•
263/56	•	263/56	
409/04	•, •	409/04	•
471/04	112	471/04	112T
H05B 33/14		H O 5 B 33/14	. В
// CO7F 15/00		CO7F 15/00	E

(72)発明者 新居 一巳

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内 F 夕一ム(参考) 3K007 AB03 CA01 CB01 DA02 DB03 EB00 FA01 4C034 AA09 CE01 4C055 AA15 BA02 BA05 BA06 BA08 BA42 BB01 BB02 CA01 DA01 DA25 4C056 AA01 AB01 AC02 AD03 AE03.

> CA03 CC01 CD01 4C063 AA01 BB01 CC92 DD12 EE10

> 4CO65 AAO4 AA19 BBO9 CCO9 DDO2

EE02 HH01 JJ01 KK01 LL01

PP01

4H050 AA03 AB92 WB14 WB21